Line-Shaped Microwave Plasma System with Rectangular Slotted Waveguide at Atmospheric Pressure

酒	井	泰		技術開発本部基盤技術研究所応用理学研究部	博士(工学)
原		正		技術開発本部基盤技術研究所応用理学研究部	課長
上	松	和	夫	技術開発本部 主席技監 工学博士	

大気圧下において,2.45 GHz のマイクロ波を用いたライン状プラズマ生成の実証を試みた.プラズマ生成には、 マイクロ波導波管にスロットを設け、そのスロットから放射される漏えい波を利用した.スロット部に挿入される 誘電体の形状や種類に着目し、試験的に検証することでライン状プラズマ生成を実証した.さらに、生成したマイ クロ波プラズマはポリカーボネート(PC)を親水化可能であることが分かった.

Line-shaped plasmas are generated with a slotted waveguide at 2.45 GHz at atmospheric pressure. Dielectric sheets are used to decrease the ignition threshold of plasma. The dependence of the plasma ignition threshold on permittivity was confirmed by measurement. Then, ignition tests were performed in which the experimental conditions were modified based on measurement results until long line-shaped plasma was generated. An experiment in which polycarbonate (PC) was exposed to plasma was performed and water contact angle measurement results confirmed that the generated plasma is effective for surface modification.

1. 緒 言

高分子材料の表面改質^{(1)~(3)}や半導体基板などのエッ チング, CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相蒸 着)などに用いられるプラズマ処理技術において,大面 積にわたる処理や,その均一性向上,ワークに対するダ メージ低減が従来から要求されている。特に表面改質にお ける処理では大気圧下で処理が可能になると真空ポンプな どの高価な装置が必要なくなり,さまざまな産業分野での 適用が期待される。

大気圧下におけるプラズマ処理には、コロナ放電やバリ ア放電などを用いた手法が提案されており、これらのプラ ズマ源をライン状に並べ、Roll to Roll(ロール状に巻い た基材を送り出して、基材の表面に処理を行った後、再び 別のロールに巻き取り、回収する生産方式)などによっ て大面積のプラズマ処理が実用化されている.しかし、こ れらの手法では生成されたプラズマは局在化し、さらに電 極がダメージを受け劣化してしまうという問題が生じてい る.

一方,マイクロ波を用いたプラズマ生成では電極を使用 しないため、上述のような電極劣化の問題が生じることは ない.また、マイクロ波によって生成されたプラズマは、 高密度と低粒子温度という二つの特性を併せもち、処理能 力が高く,被処理物へのダメージが少ないことが期待され る⁽⁴⁾.このマイクロ波によって生成されたプラズマを用 いた大面積処理技術として,マイクロ波を伝搬させる導波 管にスロットを設け,生成されるプラズマをライン状に する手法が報告されている^{(5)~(7)}.しかし,この報告で は,低圧下を条件としたプラズマ生成にとどまっている.

一般的に高圧下であるほどプラズマ生成に要するマイク ロ波の電界強度(∝√電力)は大きくなる.そのため、大 気圧下でマイクロ波を用いたプラズマ生成を試みる場合、 高出力なマイクロ波電源が必要になり、その結果、処理装 置の大型化、高コスト化を招くことになる.これを避ける ためには、小さい電力での大気圧下におけるマイクロ波に よるプラズマ生成が必要になる.

本稿では、大気圧下でのプラズマ生成を目的として、入 力電力の低減および電界強度の増加を狙い、ガス流路の工 夫や、マイクロ波伝搬用導波管内に配置する誘電体の材質 やサイズを対象としたプラズマ生成条件に関する検討を行 い、マイクロ波を用いたラインプラズマ生成を試みた.ま た、生成したプラズマを用い、高分子材料の表面改質の一 つである親水化の付与について評価した.

2. 実験装置構成

マイクロ波プラズマ生成システムの概要を第1図に示



第1図 マイクロ波プラズマ生成システム Fig. 1 Schematic illustration of experimental setup employed for generating microwave line plasma

す.最大出力1 kW の電源から出力された 2.45 GHz のマ イクロ波はアイソレータ,自動整合装置およびプラズマ生 成ユニットを伝搬し、ショートプランジャによって反射さ れ、自動整合装置の方へ戻り、定在波を形成する.このと きショートプランジャの位置を調整することで定在波の腹 および節の位置を微調整することが可能である.自動整合 装置は、プラズマ生成ユニットの導波管寸法の変化や、誘 電体の挿入によって生じるインピーダンスの不整合を調 整することでマイクロ波の反射を抑制し、プラズマ生成ユ ニット以降へマイクロ波電力を投入している.プラズマ生 成ユニットへの入出力パワーは、方向性結合器に接続され た電力計によって計測される.システムを接続する導波管 のサイズは、プラズマ生成ユニットを除きすべて標準規格 (WRI-22, WRT-2)を採用した.

3. プラズマ生成ユニットの基本指針

導波管内を伝搬するマイクロ波の基本伝搬モードは TE₁₀モードである.導波管断面では、TE₁₀モードの電界 は両端壁面で電界が 0、中央部で最大になる.プラズマ 生成ユニットではこの電界が強くなる導波管中央部に**第2** 図に示すようなスロット(長さ 410 mm,幅 3 mm)を設



けた. このスロット位置に定在波を発生させて, 導波管内 を伝搬するマイクロ波電力の一部をプラズマ生成に利用す る. 導波管に設けられたスロットは誘電体板によって内側 からふさがれている. そして, 作動ガスがガス供給ユニッ トによって導波管の外側からスロット部に吹き付けられ, スロットから放射するマイクロ波電力によってプラズマが 生成される. このとき, 大気圧下でプラズマを生成するた め, ガスの吹き出し口をスロット壁に隣接させ, 電界強度 の大きいスロットの底面が確実にガス流路の一部となるよ うにした. また導波管内の導波路の高さは, 伝搬するマイ クロ波の電界強度を強めるため, 一般的な導波管の規格よ りも高さを低く 5 mm にした.

方形導波管内の TE₁₀ モードの波長は(1)式で表され る. プラズマは,電界強度が大きい定在波の腹を中心に生 成され,電界強度が小さい節の付近では着火しない.した がって,生成されるプラズマの長さは管内波長 λ_g の半波 長(定在波の波長)より短くなる.(1)式から導出され る導波管内媒質が真空(比誘電率:1)および石英(比誘 電率:3.8)の場合の,2.45 GHz のマイクロ波の管内波長 λ_g ,を**第3**図に示す.(1)式および**第3**図から導波管内 の媒質の比誘電率が大きいほど管内波長が短くなることが 分かる.このことから,所定の導波管幅において,より長 いプラズマ領域を得るためには,導波管内に挿入する誘電 体板の材質を比誘電率の低いものにする必要がある.

$$\lambda_{g} = \frac{\lambda}{\sqrt{\varepsilon_{r}\mu_{r}}\sqrt{1-(\lambda/2a)^{2}}}$$
 (1)
 λ_{g} :導波管内の管内波長
 λ :真空中の波長

- a : 導波管の導波路幅
- *ε*_r:導波管内媒質の比誘電率
- μ,: 導波管内媒質の比透磁率



第3図 2.45 GHz の管内波長 Fig. 3 Calculated wavelength (λ_g) in the waveguide at 2.45 GHz

4. ラインプラズマ生成試験

4.1 ラインプラズマ生成実証試験

前述の設計指針を踏まえ,はじめに He (ヘリウム)ガ スを用いたラインプラズマ生成の実証試験を行った.導波 管内の定在波が真空中の管内波長により近くなるように, 管内に配置する誘電体として,その影響を避けるために比 誘電率の小さな石英を選択した.また管内波長は誘電体の 比誘電率だけでなく,導波管断面積に占める誘電体の割合 にも左右され,可能な限り誘電体の割合を少なくすること で,何も挿入しない状態に近づけることが可能になる.

このことから,石英の断面積を極力小さくし,寸法を長 さ 410 mm,幅 5 mm,厚さ 0.5 mmとした.また,導波 管の幅は 410 mmのスロットより定在波長が長くなるよ う 61.25 mmとした.プラズマ生成試験は,最初にマイ クロ波源の電源投入後,自動整合装置の調整によって反射 波が低減されたのを確認した後にHeガスを投入する手 順で行った.

第4図に生成した He プラズマを示す. この実証試験の結果,750Wの入力電力でプラズマが着火し,約230 mmの He ラインプラズマの生成に成功した. 第4図に示されるラインプラズマは両端付近の発光が弱くなっている. これは前述のように定在波の電界強度は正弦波分布となっているため,定在波の腹から離れるほど電界強度が弱まるためである.

4.2 誘電体の厚みおよび比誘電率と導波管内電界強度

前述のラインプラズマの生成試験では、導波管内のマイ クロ波電磁界への影響を避けるため、厚さ 0.5 mm の石 英を用いた. その条件では、プラズマ着火に要する電界強



Fig. 4 He line-plasma (unit : mm)

度は大きく、1 kW の電源出力では He ガスによるプラズ マ生成が限界である.産業への応用を考慮すると、目的に 応じたさまざまな作動ガスでプラズマ生成できることが望 ましい.しかし、それらは He ガスよりも着火に要する 電界強度が大きく、スロット部にはより大きな電界強度が 求められる.

導波管内に配置される誘電体厚みとその比誘電率が電界 強度にどのように寄与するか把握するため,**第5**図に示 す平行金属平板と誘電体板で構成される簡易モデルを用い て,誘電体を配置する前後の電界強度比を算出した.ここ では平行金属平板を導波管並行の上下壁と仮定している. (2)式および**第6**図に,誘電体を配置する前後で金属平 板間の電位差が変化しないと仮定したときの電界強度比を 示す.この関係から比誘電率が大きく,厚みのある誘電体 ほど,金属平板と誘電体の間で大きい電界強度を得ること が期待される.

$$\frac{E}{E_i} = \frac{\varepsilon_r b}{\varepsilon_r b - (1 - \varepsilon_r) d} \quad \dots \qquad (2)$$

E:誘電体配置時の電界強度

E_i:誘電体非配置時の電界強度

 ε_r :誘電体の比誘電率

- b: 導波管の高さ
- d : 誘電体の厚さ





第6図 誘電体の厚さと電界強度 Fig. 6 Dependence of electrical field intensity on thickness

4.3 誘電体の種類と着火しきい値

(2)式から得られる電界強度と誘電体の関係は,簡易 モデルから導かれたものであり,誘電体を導波管に挿入し たことによる高次モードの発生や,それに伴う損失の増加 など,高周波特有の影響は考慮されていない.したがっ て,誘電体の導波管内挿入に伴う電界強度の増加を検証す るには詳細な数値解析を実施するか,実験的な検討が必要 になる.

本稿では、プラズマ生成ユニット内に配置される誘電 体とプラズマ着火しきい値の関係を明確にするため、第1 表に示す比誘電率の異なる5種類の誘電体を用いたプラ ズマ着火試験を実施した.計測結果を第7図に示す.な お、誘電体の寸法は、形状による影響を避けるため、すべ て長さ400 mm、幅 10 mm、厚さ1 mm とした.

第7図が示す結果から,誘電体の比誘電率が大きいほ どプラズマ着火に必要な入力電力を低減することが確認で きる.

4.4 Ar(アルゴン)ガスラインプラズマ生成実証試験

(2)式および第7図の結果から,誘電体の厚さを 5 mm とし,He よりも着火しきい値の高いArガスプラ ズマの生成を試みた.誘電体には,比誘電率の異なる三 つの材質,石英ガラス(長さ410 mm,幅 30 mm,厚さ

第1表 導波管内部に挿入した誘電体 Table 1 Dielectric sheets used to measure the dependence of plasma ignition on permittivity

誘電体名称	比誘電率	販 売 元	型番
石英	3.8	-	-
アルミナ	10.2	アスザック株式会社	AR-99.6
ブラックアルミナ	16.7	アスザック株式会社	AR(B)
ジルコニア	44	アスザック株式会社	AZI
K-140	140	京セラ株式会社	K-140



第7図 比誘電率と He プラズマ着火しきい値 Fig. 7 Permittivity dependence of He microwave plasma ignition threshold

5 mm), アルミナおよびジルコニア(長さ 410 mm, 幅 10 mm, 厚さ 5 mm)を採用した.

試験の結果,幅の寸法は異なるがいずれの誘電体を用いた場合もArプラズマの着火に成功した. 第8図に生成したArプラズマを示す.プラズマ生成領域全体では4.1節で示した0.5mm厚の石英をスロット部に配置したときのHeラインプラズマよりも長い約400mmの破線状のラインプラズマが生成された.生成されたプラズマが破線状になったのは誘電体が厚みをもち,比誘電率が大きいことに起因して伝搬するマイクロ波の波長が短くなるためである.

これに対しては,(1)式の関係から,導波管の幅 *a* を 狭めて管内波長を伸ばすことでプラズマ長を制御すること が可能と考える.また,**第2表**にそれぞれの誘電率を用 いた場合の Ar プラズマの着火に要した入力電力を示す.



第8図 Ar ラインプラズマ(単位:mm) Fig. 8 Ar line plasma (unit:mm)

第2表 誘電体と Ar プラズマ着火しきい値の関係 Table 2 Ignition threshold of Ar plasma

	石 英	アルミナ	ジルコニア
着火しきい値 (W)	850	350	170

比誘電率が大きいほど着火しきい値が低下している.ま た,ArガスはHeよりも着火しきい値が高いが,誘電体 厚みを5mmにしたことで,前述の第7図に示すしきい 値よりも低い入力電力で着火している.また,アルミナ や特にジルコニアの場合,入力側(第8図右側)が強く 光っている.これは,前述のように導波管内の誘電体の比 誘電率が大きいほど波長が短くなることで,管内での壁面 での反射が増え,管内を伝搬する電波の進行する距離が増 加し,その結果として伝搬損失が増加するためと考えられ る.

5. 表面処理効果の確認

産業応用への適用可能性を検討するため、生成したマイ クロ波プラズマによる高分子材料の表面改質の効果につい て試験的に検証した.本稿では、表面改質の一例として、 ラベル印刷の前処理などにも用いられるプラスチック材の 親水化を対象とした.表面処理を施す試験体には、厚さ 2 mm のポリカーボネート (PC)基板を使用した.PC の 親水化⁽⁸⁾は、ラジカル化した酸素によって基板に OH 基 が付加されることに起因すると考えられる.そのため、作 動ガスとして O_2 を 1%混合した Ar ガスを用いてプラズ マ生成し、基板表面に吹き付けた.表面改質による親水化 の効果を、水滴の接触角を計測し評価した.

第9図にプラズマばく露による PC 基板の親水化のようすを示す. PC 基板表面に滴下した水滴の接触角は,処理前は約80度であったのに対し,処理後では約30度であった.このことによりマイクロ波によって生成されたプラズマによって親水性を付与できることを確認した.



第9図表面改質による親水化 **Fig.9** Efficient surface modification

6. 結 言

大気圧下におけるマイクロ波を用いたラインプラズマの 生成を目的として,作動ガス流路の工夫や導波管内部に挿 入する誘電体の材質や寸法に着目し検討を行った. その 結果,厚さ 0.5 mm のガラス板を用いることで約 230 mm の He ラインプラズマの生成に成功した. さらに,比誘 電率とプラズマ着火しきい値の関係を明らかにし,厚さ 5 mm の誘電体を用いることでプラズマ着火しきい値の大 きい Ar ガスを用いた場合でも約 400 mm のマルチライ ンプラズマの生成に成功した. また,O₂ 混合ガスを用い たプラズマでは PC 基板表面に親水性をもたせることに 成功し,産業応用への可能性を見いだした.

また、本検討ではプラズマの安定生成や長時間運用、表 面改質処理速度や均一性など実用面での詳細な課題につい て検討をしていない.これらについてはシステムの改善を 行い、今後も検討を進めていく.

— 謝 辞 —

本研究の遂行に当たり,東海大学情報理工学部,進藤春 雄教授から,多くのご助言とご協力をいただきました.こ こに記し,深く感謝いたします.

参考文献

- M. Nagatsu, A. Ito, N. Toyoda and H. Sugai : Characteristics of Ultrahigh-Frequency Surface-Wave Plasmas Excited at 915 MHz Japanese Journal of Applied Physics Vol. 38 (1999. 6) pp. 679 – 682
- (2) D. Korzec, M. Mildner, F. Hillemann and J. Engemann : 70 cm radio frequency hollow cathode plasma source for modification of foils and membranes Surface & Coatings Technology Vol. 97 No. 1 3 (1997.12) pp. 759 767
- (3) M. Kaiser, K. -M. Baumgärtner, A. Schulz, M. Walker and E. Räuchle : Linearly extended plasma source for large-scale applications Surface & Coatings Technology Vol. 116 119 (1999. 9) pp. 552 557
- (4) M. Umeno and S. Adhikary : Diamond-Like Carbon Thin Films by Microwave Surface-Wave Plasma CVD Aimed for the Application of Photovoltaic

Solar Cells Diamond and Related Materials Vol. 14 No. 11 - 12 (2005. 9) pp. 1 973 -1 979

- (5) T. Fukasawa, S. Fujii and H. Shindo : Long Line-Shaped Microwave Plasma Generation Employing a Narrow Rectangular Waveguide Japanese Journal of Applied Physics Vol. 44 (2005. 4) pp. 1 945 1 950
- (6) H. Shindo, Y. Kimura and M. Suzuki : Proceedings
 Gas Discharges 17th International Conference
 Cardiff, U. K. (2008) p. 417
- (7) Y. Kimura, H. Kawaguchi, S. Kagami, M. Furukawa and H. Shindo : A New Method of Line Plasma Production by Microwave in a Narrowed Rectangular Waveguide Applied Physics Express Vol. 2 No. 12 (2009)
- (8) J. Lai, B. Sunderland, J. Xue, S. Yan, W. Zhao,
 M. Folkard, B. D. Michael and Y. Wang : Study on hydrophilicity of polymer surfaces improved by plasma treatment Applied Surface Science Vol. 252 No. 10 (2006.3) pp. 3 375 - 3 379